



**Министерство Образования и Науки
Российской Федерации,
Российская Академия Наук,
Физический факультет МГУ им.
М.В.Ломоносова,
Физико-Технический Институт им.
А.Ф.Иоффе РАН.**

**5-я Всероссийская Конференция
«Нитриды галлия, индия и алюминия:
структуры и приборы»
Физический факультет МГУ им.
М.В.Ломоносова
Москва, 31 января - 02 февраля 2007 г.**

Исследования, разработки и промышленное освоение полупроводниковых структур и приборов на основе нитрида галлия и его твердых растворов продолжают в последние годы развиваться рекордными темпами. Выпускаются эффективные светодиоды, созданы инжекционные лазеры, мощные высокочастотные транзисторы. Перспектива замены ламп накаливания и люминесцентных ламп светодиодами

излучателями на основе нитрида галлия начинает обретать реальные формы. В ведущих промышленно развитых странах созданы национальные программы развития твердотельного освещения, рассчитанные на 5-10-20 лет. Во всем мире новая светотехническая промышленность, основанная на твердотельных источниках света, будет иметь к 2020 г. оборот более 40 млрд. долларов в год. По этой тематике проходит ежегодно много международных и региональных конференций и симпозиумов.

В России в 2001-2005 гг. (в Москве и Санкт-Петербурге) прошли четыре Всероссийские Конференции «Нитриды галлия, индия и алюминия: структуры и приборы». Конференции получали поддержку РФФИ и Минпромнауки. В Конференции 2005 г. приняли участие более 160 человек, представивших 81 доклад от 60 организаций: ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН, МГУ им. М.В.Ломоносова, ИФП СО РАН, ГИРЕДМЕТ, МИСИС, и др. Спонсорами Конференции 2005 г. были Российский Фонд Фундаментальных Исследований, фирмы «ACOL Technologies», «Светлана - Оптоэлектроника», «Aixtron», «TDI».

Конференции показали, что за последние годы в России существенно увеличился интерес к научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам по полупроводниковым нитридам металлов III группы (GaN, AlN, InN и их твердым растворам). Работы ведутся по технологии выращивания кристаллов, создания гетероструктур и p-n-переходов, по исследованию физических свойств этих материалов и приборов на их основе, по разработкам устройств, использующих эти приборы. Создаются устройства и системы энергосберегающего освещения на базе светодиодных технологий. Рядом организаций приобретено современное технологическое оборудование и начато промышленное производство светодиодов и светотехнических устройств на их основе. В работы по этой тематике включились, кроме столичных институтов и фирм, организации и предприятия Сибири, Урала и Поволжья. Создаются программы исследований и разработок по этой тематике, рассчитанной на длительный период, включающие участие промышленных, академических и университетских организаций.

СРОКИ И ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИИ:

В конце января – начале февраля 2007 г. в Москве, на физическом факультете МГУ им. М.В.Ломоносова, планируется проведение **5-й Всероссийской Конференции**

«Нитриды галлия, индия и алюминия: структуры и приборы».

Она будет проходить на физическом факультете МГУ.

Опираясь на опыт предыдущих Совещаний и Конференций, а так же учитывая расширение круга участников, оргкомитет планирует проведение Конференции в течение трех дней, срок – 31 января - 02 февраля 2007 года. Предполагаемый формат – устный и стендовый. Каждая устная сессия будет предваряться приглашенными докладами. Каждому участнику будет дано время для устного доклада или стенд для представления результатов. Официальный язык Конференции – Русский. Часть докладов (от зарубежных участников) может быть сделана на Английском языке. На Конференции будет организована выставка промышленных компаний.



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

1. Подложки для эпитаксиального роста нитридов.
2. Технология материалов: рост объемных кристаллов.
3. Технология материалов: эпитаксиальные методы роста.
4. Оптические, электрические и структурные свойства материалов.
5. Свойства квантово-размерных структур на основе нитридов.
6. Конструкции и технологии (ростовые и постростовые) приборов на основе нитридов.
7. Электронные и фотоэлектрические приборы на основе нитридов.
8. Светодиоды и лазеры на основе нитридов.
9. Специальная сессия "Энергосберегающее освещение на основе светодиодных технологий".

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Развернутые тезисы докладов на Русском языке (на 2 стр. по прилагаемой форме) и краткие тезисы на Английском языке (100 слов по прилагаемой форме) следует направлять до 1 Декабря 2006 года по электронной почте (Nitrides2007@mail.ioffe.ru).

Тезисы докладов будут опубликованы до начала конференции.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ:

Оргкомитет обратился в МинОбрНауки, РФФИ и к спонсорам с просьбами о финансовой поддержке. Российские участники получают финансовую поддержку в зависимости от выделенных средств и сроков предварительной регистрации.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ:

Оргкомитет убедительно просит заполнить и прислать Форму Предварительной Регистрации в электронном виде по одному из адресов: andrey.turkin@acol.biz или Nitrides2007@mail.ioffe.ru

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ:

Тезисы доклада на Русском языке представляются

- В электронном виде в редакторе Microsoft Word 6.0 – XP
- Объем публикации – 2 страницы
- Формат страницы 17 X 24 см, все поля 2.4 см. Шрифт – Times New Roman 10, 1 интервал. Печать будет производиться без масштабирования.
- Заголовок, авторы, организации и адреса – центрированы, основной текст – выровнен. • Заголовок – заглавными буквами жирным шрифтом.
- Авторы – жирным курсивом.
- Автор, представляющий доклад – подчеркнут. • Автор, с которым должна осуществляться переписка по e-mail – помечен символом *.
- Далее (с новой строки) – организация, адрес и электронный адрес – обычным шрифтом.
- Если работа представлена от нескольких организаций – авторы в общем списке помечены индексами сверху (1, 2, ...), названия и адреса организаций – друг под другом, каждый – с новой строки.

- Между названием и списком авторов и между адресом организации(й) и основным текстом – пустая строка.
- Формулы – по возможности, с применением латинского шрифта и шрифта Symbol; центрированы. В крайнем случае – применять Equation Editor.
- Ссылки – по правилам «ФТП»
Использование автоматических ссылок и сносок запрещено.
- Рисунки - черно-белые, вставлены в doc-файл из файлов, подготовленных в приложениях.
- Рекомендованная ширина рисунка – половина (6 см) или вся ширина полосы. Оптимальным является вставка рисунков попарно в таблицу (2 колонки) в начале или конце страницы с размещением подписей к рисункам в той же таблице. В противном случае, при вставке отдельного рисунка, подпись к нему размещать в общем с рисунком исходном графическом файле.
- Использование таблицы для «обтекания» основным текстом рисунка – недопустимо.
- Без нумерации страниц.

Краткие тезисы на Английском языке (название, авторы, организация, 100 слов текста) на отдельной странице.

**СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ –
до 1 ДЕКАБРЯ 2006 г.!**

Форма предварительной регистрации (ОТДЕЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО ПРЕДПОЛАГАЕМОГО УЧАСТНИКА)

1. Фамилия, Имя, Отчество.
2. Организация.
3. Должность.
4. Ученая степень, ученое звание.
5. Количество предполагаемых докладов (представляемых лично Вами).
6. Темы докладов, представляемых данным участником (в соответствии с нумерацией, приведенной в программе Конференции).
7. Необходимость финансовой поддержки.
8. Необходимость резервирования места в гостинице.
9. Телефон, E-mail.

**СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМЫ -
до 01 ноября 2006 г.**

ОРКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

П.К.Кашкаров	МГУ им. М.В.Ломоносова, председатель
А.Э.Юнович	МГУ им. М.В.Ломоносова, зам. председателя
П.С.Копьев	ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН, зам. Председателя
А.Н.Туркин	МГУ им. М.В.Ломоносова, ученый секретарь
В.В.Лундин	ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН, ученый секретарь
А.А.Арендаренко	ЗАО "Элма-Малахит"
В.Н.Данилин	ГУП "Пульсар"
П.В.Иванников	МГУ им. М.В.Ломоносова
А.Ф.Иванов	РФЯЦ – ВНИИТФ, МинАтом, Снежинск
А.Ю.Игнатов	ЗАО «Монокристалл»
Г.В.Иткинсон	“Светлана -Оптоэлектроника”
А.Н.Ковалев	МИСиС
В.Г.Мокеров	ИСВЧПЭ РАН
А.Е.Николаев	ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН
М.А.Ормонт	МГУ им. М.В.Ломоносова
В.Г.Сидоров	СПбГТУ
П.А.Форш	МГУ им. М.В.Ломоносова
М.В.Чукичев	МГУ им. М.В.Ломоносова

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

А.Э.Юнович	МГУ им. М.В.Ломоносова, председатель
П.С.Копьев	ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН, зам.
Председателя	
А.В.Сахаров,	ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН, секретарь
Л.М.Коган	НПЦ «Оптэл»
В.В.Лундин	ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН
Ю.Н.Макаров	ЗАО «Нитридные кристаллы»
Ф.И.Маняхин	МИСИС
М.Г.Мильвидский	ГИРЕДМЕТ
О.П.Пчеляков	ИФП СО РАН
В.Г.Сидоров	СПбГТУ
С.Ю.Шаповал	ИПТМ РАН